

# BT131 双向可控硅

## •产品特点

NPNPN 五层结构的硅双向器件;P 型对通扩散隔离;  
台面玻璃钝化工艺;背面多层金属电极

## •主要用途

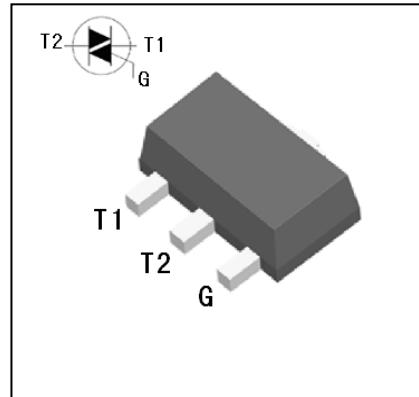
加热控制器;调光、调速控制器;彩灯控制器;  
电风扇、搅拌机、果汁机等家用电器;

## •封装形式

SOT-89-3L

### ●主要参数( $T_j=25^{\circ}\text{C}$ )

符号	项目	数值	单位
$I_{\text{T(RMS)}}$	通态平均电流	1	A
$V_{\text{DRM}}/V_{\text{RRM}}$	断态/反向重复值电压	$\geqslant 600$	V
$I_{\text{TSM}}$	通态不重复浪涌电流	10	A



T1:主端子 1

T2:主端子 2

G:触发极

## ●极限参数

符号	参数和条件	数值	单位
$I_{\text{T(RMS)}}$	通态平均电流 $T_{\text{lead}} \leqslant 51^{\circ}\text{C}$	1	A
$V_{\text{DRM}}/V_{\text{RRM}}$	断态重复值电压 $T_j=25^{\circ}\text{C}$ / 反向重复值电压 $T_j=25^{\circ}\text{C}$	BT131-600	V
$I_{\text{TSM}}$	通态不重复浪涌电流 $T_j=25^{\circ}\text{C}$ , 完全正弦波	tp=20ms	10
		tp=16.7ms	11
$I^2t$	$I^2t$ 值 (tp=10ms)	1.28	$\text{A}^2\text{s}$
$I_{\text{GM}}$	控制极峰值耗散电流	2	A
$V_{\text{GM}}$	控制极峰值耗散电压	5	V
$P_{\text{GM}}$	控制极峰值耗散功率	5	W
$P_{\text{G(AV)}}$	控制极平均耗散功率	0.5	W
$dI_{\text{T}}/dt$	通态电流临界上升率 ( $I_{\text{TM}}=1.5\text{A}$ , $I_{\text{G}}=0.2\text{A}$ , $d I_{\text{G}}/dt=0.2\text{A}/\mu\text{s}$ )	T2+ G+	50
		T2+ G-	50
		T2- G-	50
		T2- G+	10
T <sub>stg</sub> T <sub>j</sub>	贮存温度 操作结口温度	-40--+150	°C
		-40--+110	

# HTC Semiconductor series

---



---

## ●热阻

符号	参数	数值	单位
R <sub>th</sub> (j-lead)	热阻结到引线	60	K/W
R <sub>th</sub> (j-a)	热阻结到环境	150	K/W

## ●电特性 (T<sub>j</sub>=25°C 除非有其它的温度存在)

符号	特性和测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I <sub>GT</sub>	控制极触发电流 V <sub>D</sub> =12V, I <sub>T</sub> =0.1A	T2+ G+	----	0.8	3
		T2+ G-	----	2.0	3
		T2- G-	----	2.5	3
		T2- G+	----	4.0	5
I <sub>L</sub>	擎住电流 V <sub>D</sub> =12V, I <sub>GT</sub> =0.1A	T2+ G+	----	1.2	5
		T2+ G-	----	4.0	8
		T2- G-	----	1.0	5
		T2- G+	----	2.5	8
I <sub>H</sub>	维持电流 V <sub>D</sub> =12V, I <sub>GT</sub> =0.1A	----	1.3	5	mA
V <sub>TM</sub>	通态峰值电压 I <sub>T</sub> =2.0A	----	1.2	1.7	V
V <sub>GT</sub>	控制极触发电压 V <sub>D</sub> =12V, I <sub>GT</sub> =0.1A V <sub>D</sub> =400V, I <sub>GT</sub> =0.1A, T <sub>j</sub> =125°C	----	0.7	1.5	V
		0.2	0.3	----	
I <sub>D</sub>	V <sub>D</sub> =V <sub>DRM(MAX)</sub> , T <sub>j</sub> =125°C	----	0.1	0.5	mA

## ●动态参数

符号	特性和测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
dV <sub>D</sub> /dt	换向电压临界上升率 V <sub>DM</sub> =67% V <sub>DRM(MAX)</sub> , T <sub>j</sub> =125°C 指数波形, R <sub>GK</sub> =0.1K Ω	5	15	----	V/ μ s
t <sub>gt</sub>	V <sub>D</sub> =V <sub>DRM(MAX)</sub> , I <sub>TM</sub> =1.5A, I <sub>G</sub> =0.1A, dL <sub>G</sub> /dt=5A/ μ s	----	2	-----	μ s